

08.05.2026 - 07:05 Uhr

## **U.S. International Trade Commission (ITC) entscheidet zugunsten von Infineon und verhängt ein Import- und Vertriebsverbot gegen Innoscience**

München (ots) -

- ITC hat im Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience zugunsten von Infineon entschieden
- Die Behörde untersagt Innoscience den Import und Verkauf von Galliumnitrid-Produkten in den USA
- Entscheidung unterstreicht erneut den Wert des branchenführenden Patentportfolios von Infineon

Die Full Commission der US International Trade Commission (ITC) hat die vorläufige Feststellung vom Dezember 2025 bestätigt, wonach Innoscience ein Infineon-Patent im Bereich der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie verletzt hat. Die Behörde ordnete ein Import- und Verkaufsverbot gegen Innoscience an. Diese Entscheidung und die Unterlassungsverfügungen unterliegen einer 60-tägigen Überprüfungsfrist durch den US-Präsidenten.

„Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Stärke des geistigen Eigentums von Infineon. Sie bestätigt unser Engagement, das Patentportfolio von Infineon konsequent zu schützen und einen fairen Wettbewerb im Markt sicherzustellen“, sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter des GaN-Geschäfts bei Infineon. „Mit unserer branchenführenden 300-Millimeter-GaN-Fertigung sind wir herausragend positioniert, um Innovationen zu skalieren. Dadurch können wir unseren Kunden genau die Leistungs-, Qualitäts- und Kostenvorteile bieten, die sie benötigen, um die Dekarbonisierung und Digitalisierung weiter voranzutreiben“, fügt er hinzu.

Das Urteil ist eine weitere positive Entscheidung, die die Rolle von Infineon im Bereich der GaN-Technologie unterstreicht. In einem weiteren Rechtsstreit in Deutschland macht Infineon die Verletzung von drei Patenten und eines Gebrauchsmusters vor dem Landgericht München I geltend. Bereits im August 2024 hat das Münchner Gericht eine Verletzung des ersten Infineon-Patents durch Innoscience festgestellt. Die Verhandlungen zu einem Patent und einem Gebrauchsmuster sind für Juni 2026 angesetzt.

Infineon ist ein führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mit dem branchenweit breitesten IP-Portfolio, das rund 450 GaN-Patentfamilien umfasst. GaN spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung leistungsstarker und energieeffizienter Leistungssysteme in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter erneuerbare Energiesysteme, KI-Rechenzentren, industrielle Automatisierung und Elektrofahrzeuge (EVs). Durch höhere Leistungsdichte, schnellere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichen GaN-Halbleiter kompaktere Designs, verringern Energieverbrauch und Wärmeentwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Leistungssysteme beherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.infineon.com](http://www.infineon.com)

Diese Presseinformation finden Sie online unter [www.infineon.com/presse](http://www.infineon.com/presse)

Follow us: [Facebook](#) - [LinkedIn](#)

Pressekontakt:

Infineon Technologies AG

Media Relations:

Felix Sparkuhle

+49 89 234 38991

felix.sparkuhle@infineon.com

Investor Relations:

+49 89 234 26655

investor.relations@infineon.com

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100004630/100939959> abgerufen werden.